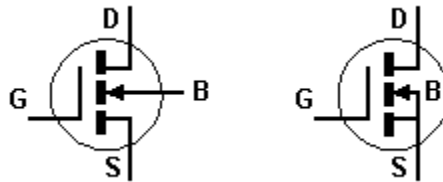
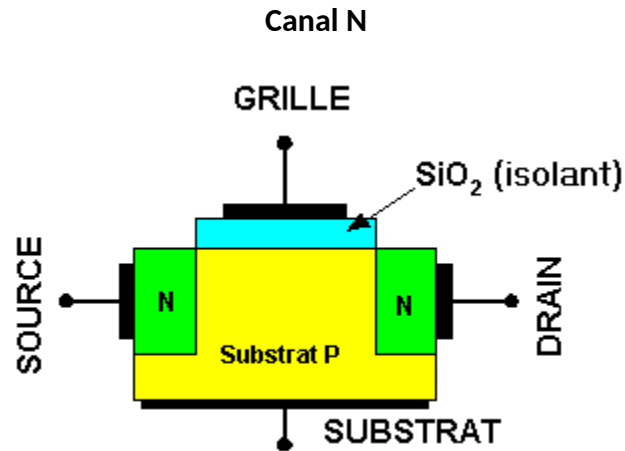
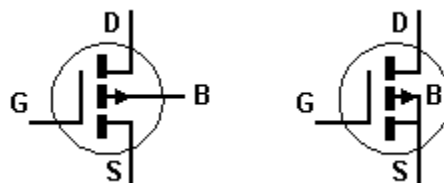
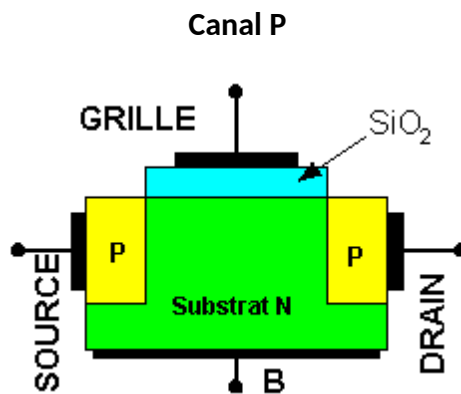


MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

MOSFET à enrichissement (Enhancement-MOSFET ou E-MOSFET)



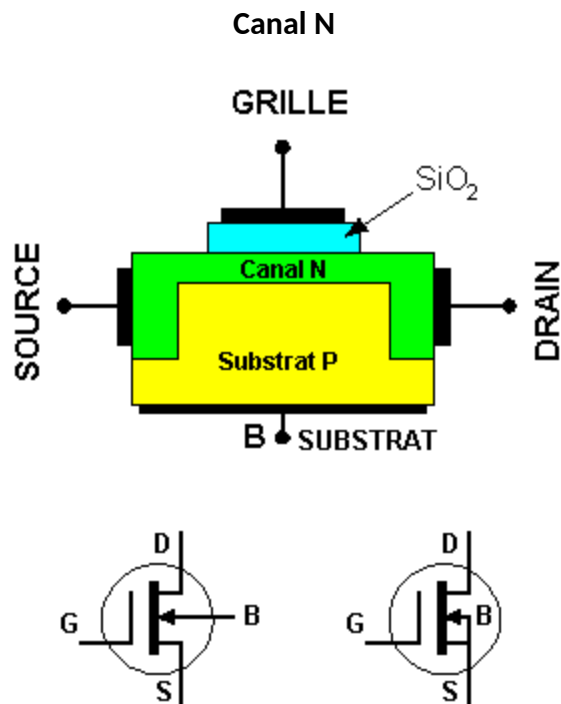
En appliquant une tension positive sur la grille par rapport au substrat, un canal se forme entre le drain et la source : la conductivité augmente, le transistor devient passant.



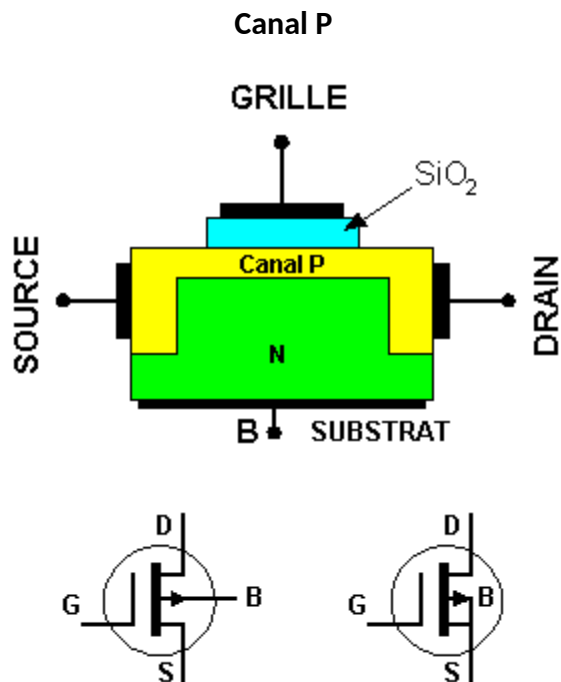
En appliquant une tension négative sur la grille par rapport au substrat, un canal se forme entre le drain et la source : la conductivité augmente, le transistor devient passant.

Sans tension de commande, le E-MOSFET est bloqué.

MOSFET à appauvrissement (Depletion-MOSFET ou D-MOSFET)



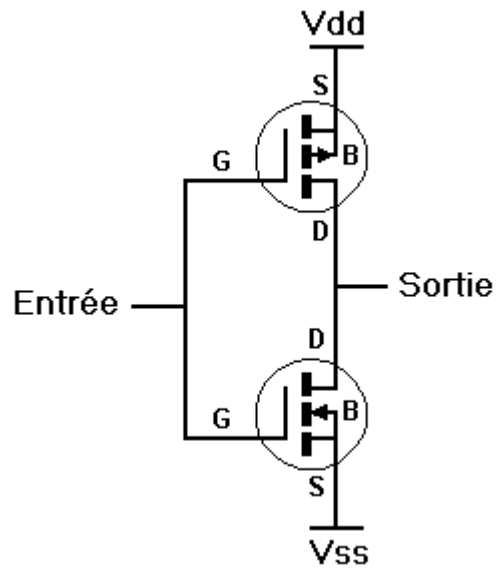
En appliquant une tension négative sur la grille par rapport au substrat, on pince le canal : la conductivité diminue, le transistor se bloque.



En appliquant une tension positive sur la grille par rapport au substrat, on pince le canal : la conductivité diminue, le transistor se bloque.

Sans tension de commande, le D-MOSFET est passant.

Technologie CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)



Quand l'entrée est à 1 (V_{dd}), le transistor du bas est passant et celui du haut est bloqué : la sortie est à 0 (V_{ss}).
Quand l'entrée est à 0 (V_{ss}), le transistor du bas est bloqué et celui du haut est passant : la sortie est à 1 (V_{dd}).